

## 2SC1406, 2SC1407

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ型/Si NPN Epitaxial Planar

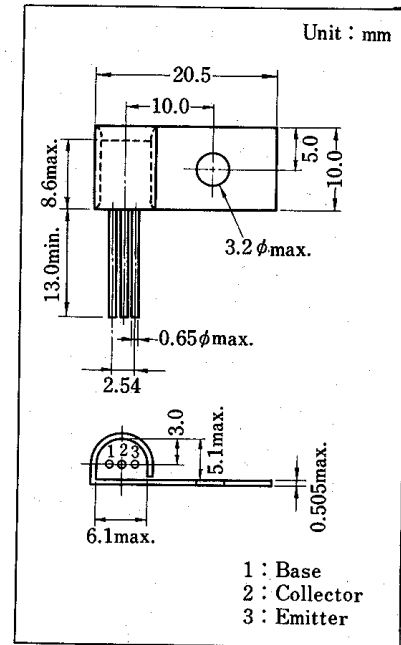
低周波電力増幅および励振用/AF Power Amplifier and Driver  
2SA751, 2SA752 とコンプリメンタリ/Complementary pair  
with 2SA751, 2SA752

## 特 徴/Features

- コレクタ・エミッタ飽和電圧  $V_{CE(sat)}$  が低い。/Low  $V_{CE(sat)}$
- 2SA751, 2SA752 とコンプリメンタリペアで出力 2~3W が得られます。/  
2~3W-output in complementary pair with 2SA751, 2SA752

最大定格/Absolute Maximum Ratings ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	2SC1406 30	V
		2SC1407 60	
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	2SC1406 25	V
		2SC1407 50	
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$I_{CM}$	1.5	A
コレクタ電流	$I_C$	1	A
コレクタ損失	$P_C$	Without heat sink 750	mW
		With a heat sink No. 38 1000	
接合部温度	$T_j$	135	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+135	$^\circ\text{C}$

電気的特性/Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	2SC1406 30			V
			2SC1407 60			
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	$I_C=2\text{mA}, I_B=0$	2SC1406 25			V
			2SC1407 50			
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	5			V
コレクタレキ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$			0.1	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE1}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=500\text{mA}^*$	60	160	340	
	$h_{FE2}$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}^*$	50	100		
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}^*$		0.2	0.4	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}^*$		0.85	1.2	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CB}=10\text{V}, -I_E=50\text{mA}^*$		200		MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$		11	20	pF

詳細は 336 頁 (2SC1383, 2SC1384, 2SC1406, 2SC1407) をご参照ください。  
Details refer to page 336 (2SC1383, 2SC1384, 2SC1406, 2SC1407)

\* パルス測定/Pulse Test